

性能特点

- 高精度 MEMS 微米加工
- 高性能、全屏蔽、抗干扰微型腔体滤波器
- 硅基片、50Ω 共面波导输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块应用

环境参数

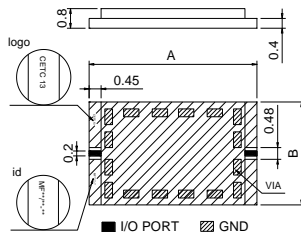
| | |
|--------|--------------|
| 工作温度 | -55°C~+85°C |
| 存储温度 | -55°C~+125°C |
| 最高输入功率 | 35dBm |

电特性(T_A=+25°C)

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------------|---------------------|------|------|-----|
| 中心频率(f ₀) | - | 11.7 | - | GHz |
| 通带频率范围 | 10.9 | - | 12.5 | GHz |
| 带内波动 | - | - | 1 | dB |
| 中心插损 | - | - | 1.5 | dB |
| 回波损耗 | 13 | - | - | dB |
| 带外衰减 | ≥ 30@8GHz&13.8GHz | | - | dB |
| | ≥ 40@6.5GHz&13.4GHz | | - | dB |
| | ≥ 55@DC~4GHz | | - | dB |
| | ≥ 50@15~19GHz | | - | dB |
| 时延波动 | ≤ 1@10.9~12.5GHz | | - | ns |
| 线性相位 | ≤ ± 4@10.9~12.5GHz | | - | ° |

S2P 文件名: SiMF11R7_1R6-2.s2p

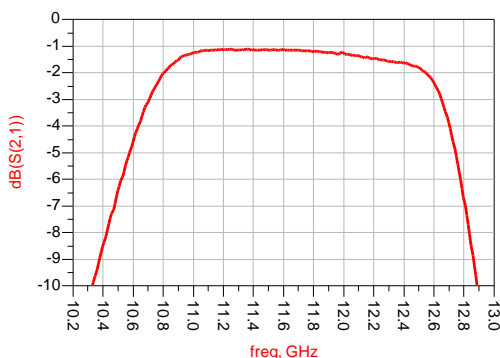
外形尺寸



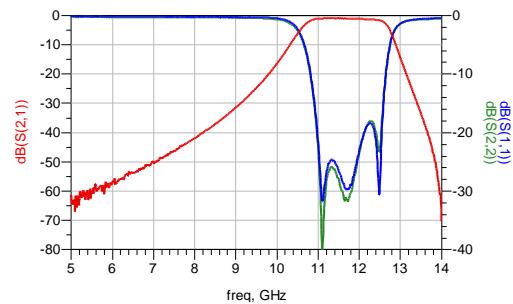
| 尺寸符号 | 数值(mm) | | |
|------|--------|-----|-----|
| | 最小值 | 公称值 | 最大值 |
| A | 4.9 | - | 5.0 |
| B | 4.1 | - | 4.2 |

典型测试曲线

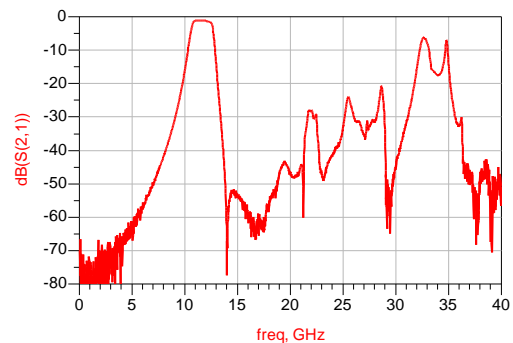
通带损耗 VS 频率(T_A=25°C)



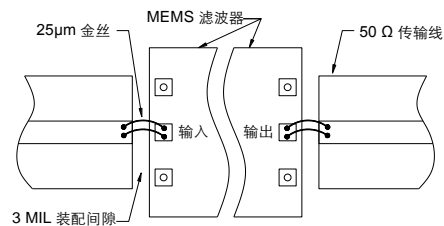
带外抑制 & 回波损耗 VS 频率(T_A=25°C)



远端抑制 VS 频率(T_A=25°C)

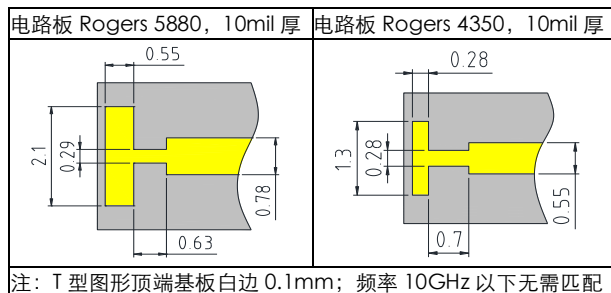


建议装配图



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，两侧距侧壁 0.2mm，表面距上盖 3mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上，载体厚度 ≥ 0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配，T 型尺寸如下：



注: T 型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配

5. 有问题请与供货商联系。